










| | |
|---|---|
|  | <p>SI7860ADP-T1-GE3</p> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: SI7860ADP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 11A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7860ADP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5673 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | SI7860ADP-T1-GE3 |
| Hersteller | Vishay / Siliconix |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 30V 11A PPAK SO-8 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 5673 pcs Stock |
| Serie | TrenchFET® |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Verpackung / Gehäuse | PowerPAK® SO-8 |
| Supplier Device-Gehäuse | PowerPAK® SO-8 |
| Verlustleistung (max) | 1.8W (Ta) |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 11A (Ta) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 9.5 mOhm @ 16A, 10V |
| VGS (th) (Max) @ Id | 3V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 18nC @ 4.5V |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |

SI7860ADP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7860ADP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7860ADP-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7860ADP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|---|---|---|---|
|  <p>SI7860ADP SI SI7860ADP SI</p> |  <p>SI7860ADP-T1-E3 VISHAY SI7860ADP-T1-E3 VISHAY</p> |  <p>SI7860ADP-T1-E3 QFN8 VISHAY SI7860ADP-T1-E3 QFN8 VISHAY</p> |  <p>SI7860DP VISHAY SI7860DP VISHAY</p> |
|  <p>SI7860DP-T1 VISHAY SI7860DP-T1 VISHAY</p> |  <p>SI7860ADP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 11A PPAK SO-8</p> |  <p>SI7860ADP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 11A PPAK SO-8</p> |  <p>SI7860DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 11A PPAK SO-8</p> |

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--|--|--|---|--|
|  SI7852ADP-T1-GE3 |  SI7852DP |  SI7852DP-T1-E3 |  SI7852DP-T1-E3 |  SI7852DP-T1-GE3 |
|  SI7852DP-T1-GE3 |  SI7856ADP |  SI7856ADP-T1-E3 |  SI7856ADP-T1-E3 |  SI7856ADP-T1-GE3 |
|  SI7856ADP-T1-GE3 |  SI7856DP-T1 |  SI7856DP-T1-GE3 |  SI7856DP-T1-E3 |  SI7858ADP |
|  SI7858ADP-T1-E3 |  SI7858ADP-T1-E3 |  SI7858ADP-T1-GE3 |  SI7858ADP-T1-GE3 |  SI7858BDP |
|  SI7858BDP-T1-E3 |  SI7860ADP |  SI7860ADP-T1-E3 |  SI7860ADP-T1-E3 |  SI7860ADP-T1-GE3 |
|  SI7860ADP-T1-E3 |  SI7860DP |  SI7860DP-T1 |  SI7860DP-T1-E3 |  SI7860DP-T1-E3 |
|  SI7860DP-T1-GE3 |  SI7860DP-T1-GE3 |  SI7860DP-T1-E3 |  SI7862ADP |  SI7862ADP-T1-E3 |
|  SI7862ADP-T1-E3 |  SI7862ADP-T1-GE3 |  SI7862ADP-T1-GE3 |  SI7862DP |  SI7862DP-T1 |
|  SI7864ADP |  SI7864ADP-T1-GE3 |  SI7864DP-T1-GE3 |  SI7866ADP |  SI7866ADP-T1-E3 |
|  SI7866ADP-T1-E3 |  SI7866ADP-T1-GE3 |  SI7866ADP-T1-GE3 |  SI7866DP-T1 |  SI7866DP-T1-E3 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited